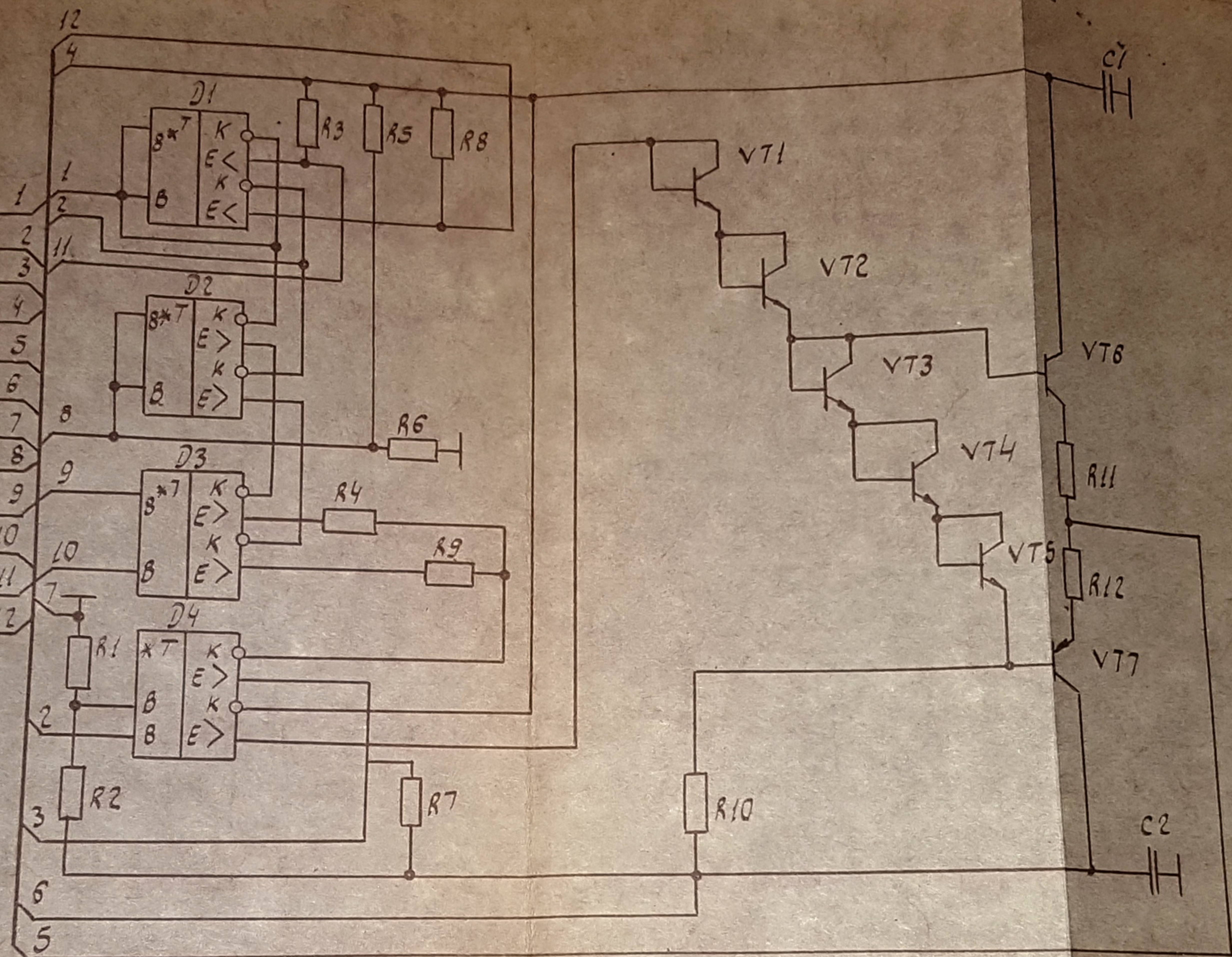


E33.086.01433

Цель	Конт.
Коррекция	1
"	4
Режим	11
+ Епит.	5
Выход	6
- Епит.	10
Корпус	8, 15
Режим	12
Вход +	13
Вход -	14
Баланс	2
"	3



Резисторы R1...R12 выполнить вакуумным напылением и фотолитографией

E33.086.01433

№ докум.	E33.086.01433	Эл. схема	Микросборка 04УД004	Лист	1	Масштаб	
Разраб.	Семенов	Проф.	Семенов	Дата		01	
Тех. контр.		Исполн.	Милехин	Дата			
Исп. контр.		Исп.	Бычкова	Дата			
Утв.		Исп.	Молехин	Дата			

Подпись

Усилитель
операционный
Схема электрическая
принципиальная

01, 02 Конденсатор К10-17-2в-Н90-0,01 мкФ -1
ОЖО.460.107 ТУ нелуженые

2

Д1 Кремниевая транзисторная пара
2ТС 393А-1 ХМЗ.363.000 ТУ

1

02...Д4 Кремниевая транзисторная пара
2ТС 398А-1 СВО.336.063 ТУ

3

②

Резисторы

R1	1,5 кОм ± 20% 2,0 мВт	1	$\frac{R2}{R1} = 1,8 \pm 2\%$
R2	2,7 кОм ± 20% 4,0 мВт	1	$\frac{R1}{R7} = 3 \pm 2\%$
R3	100 Ом ± 20% 3,0 мВт	1	$\frac{R3}{R8} = 1 \pm 2\%$
R4	10 Ом ± 20% 0,3 мВт	1	$\frac{R4}{R9} = 1 \pm 2\%$
R5	3,5 кОм ± 20% 10 мВт	1	$\frac{R5}{R6} = 2,33 \pm 2\%$
R6	1,5 кОм ± 20% 4,0 мВт	1	} Выходим
R7	500 Ом ± 20% 15 мВт	1	
R8	100 Ом ± 20% 3,0 мВт	1	
R9	10 Ом ± 20% 0,3 мВт	1	
R10	1 кОм ± 20% 50 мВт	1	
R11, R12	30 Ом ± 20% 30 мВт	2	$\frac{R11}{R12} = 1 \pm 2\%$

17.06.85 *Семенов*

Собчук П.М.

Согласовано



ЕЭЗ

№	№ докум.	Подп.	Дата
1	ЕЭЗ68196	Волы	29.11.85
2	ЕЭЗ67004	Восар	27.5.85

ЕЭЗ.086.014 ПЭЗ

Разраб.	Семенов	<i>Семенов</i>	22.2.84
Провер.	Семенов	<i>Семенов</i>	22.2.84
Уч. НИС	Милехин	<i>Милехин</i>	23.2.84
В. контр.	Бычкова	<i>Бычкова</i>	13.3.84
Утв.	Милехин	<i>Милехин</i>	23.2.84

Микросборка 04УД004
УСИЛИТЕЛЬ
операционный

Лит.	Лист	Листов
01	1	2

Перечень элементов

Транзисторы

VT1...VT5	2Т324Б-1 СВ0.336.021 ТУ	5	
VT6	2Т378Б1-2 ХА3.365.012 ТУ	1	
VT7	2Т364Б-2 ШТ3.365.060 ТУ	1	

Е33.086.014 ПЭЗ